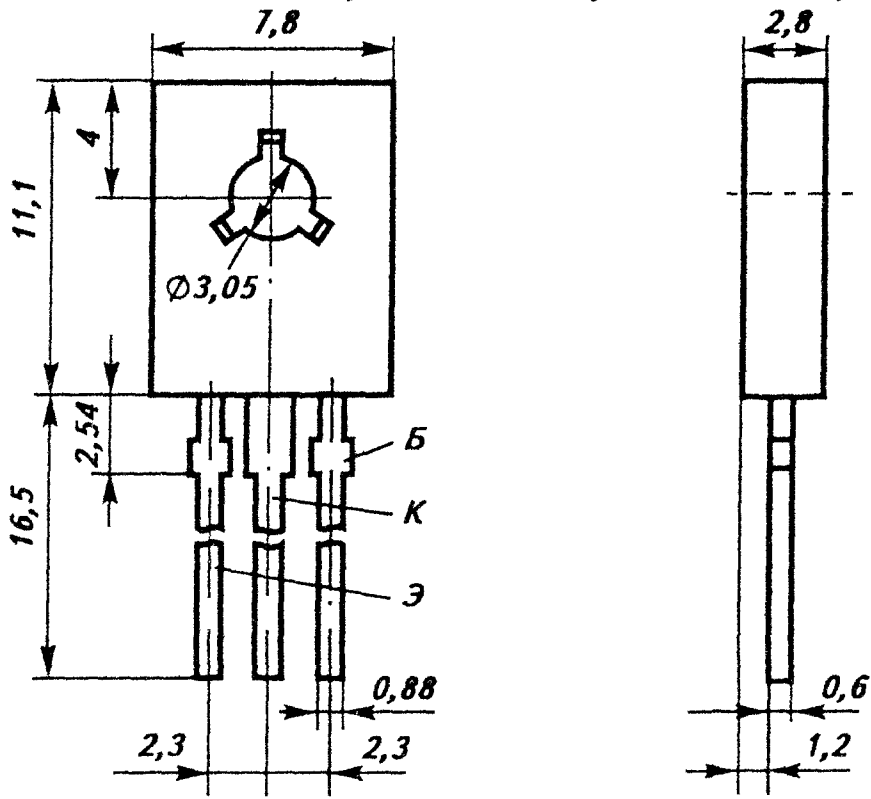


□ **КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е.**



КТ683(А-Е)

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10$ В,

$I_{к} = 0,15$ А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г	40..120
КТ683Б, КТ683Д	80...240
КТ683Е	160..480

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В,

$I_{э} = 50$ мА,

не менее	50 МГц
----------------	--------

Граничное напряжение при $I_{э} = 30$ мА, не менее

КТ683А	90 В
КТ683Б, КТ683В	80 В
КТ683Г	60 В
КТ683Д, КТ683Е	40 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к} = 0,15$ А, $I_{б} = 15$ мА,

не более	0,45 В
----------------	--------

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к} = 0,15$ А, $I_{б} = 15$ мА,

не более	1 В
----------------	-----

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при $I_{к} = 0,1$ мА, $R_{бэ} = 3$ кОм,

не менее:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В

Пробивное напряжение база-эмиттер при $I_{э} = 0,1$ мА, не менее

КТ683А, КТ683Б, КТ683В	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е	5 В

Время включения при $U_{кб} = 40$ В, $I_{к} = 0,2$ А, $I_{б} = 40$ мА,

типичное значение	0,1* мкс
-------------------------	----------

Время выключения при $U_{кб} = 40$ В, $I_{к} = 0,2$ А, $I_{б} = 40$ мА,

типичное значение	0,2* мкс
-------------------------	----------

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более

.....	15* пФ
-------	--------

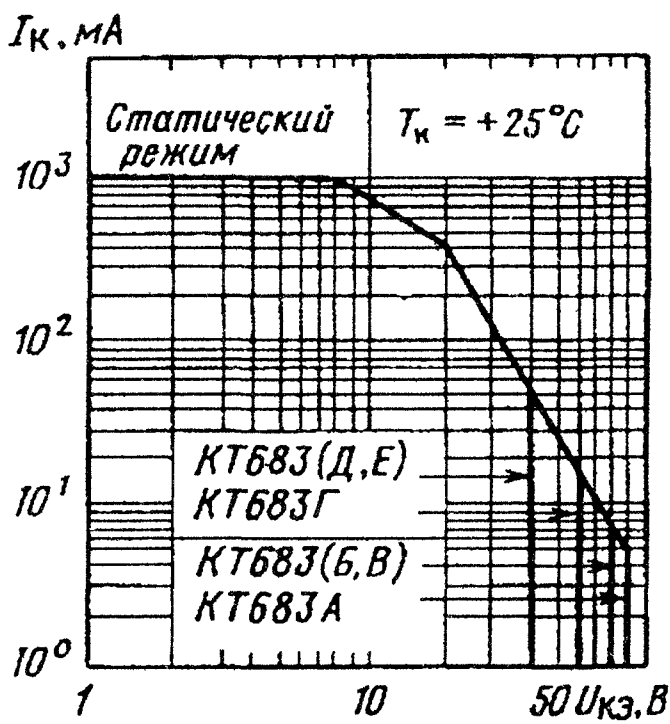
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5$ В, не более

.....	65* пФ
-------	--------

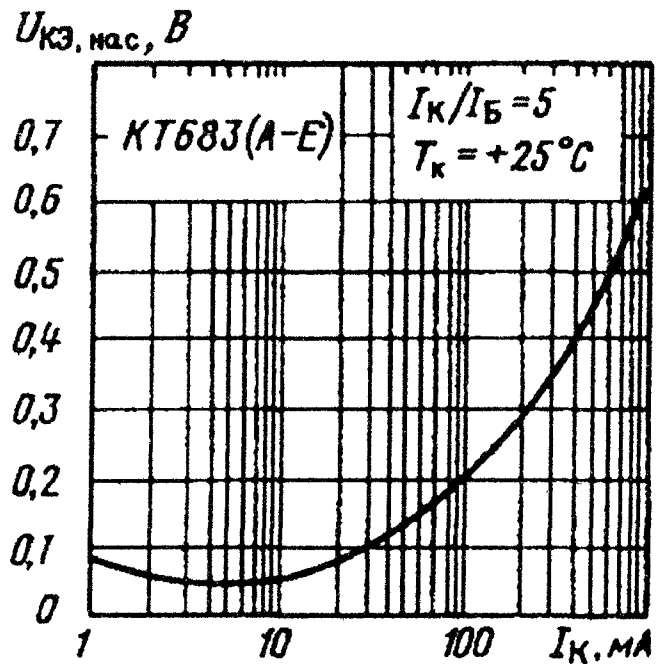
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 90$ В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В

и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более

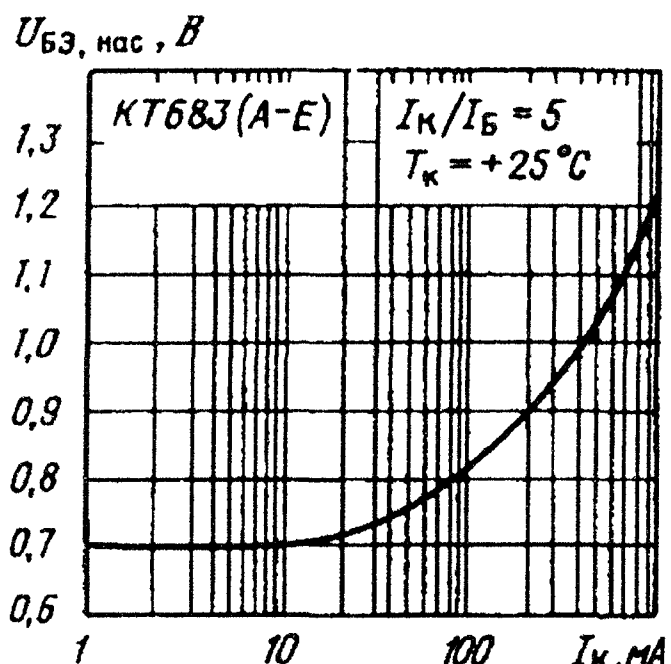
1 мкА



Области безопасной работы транзисторов



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора